

Germanium PNP Transistor


GC101

15V / 15mA

DATASHEET

OEM – RFT

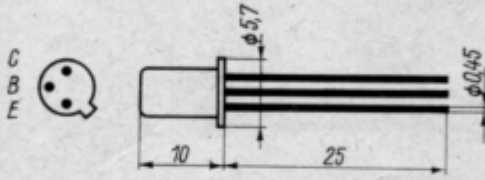
Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72



RFT
electronic

GC 101


Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-a und A 3/25-b nach TGL 11 811 für rauscharme Verstärker, Misch- und Oszillatorstufen im Nieder- und Mittelfrequenzgebiet.



Masse ca. 0,8 g

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung		$-U_{CBO} = 15 \text{ V}$
Emitter-Basis-Spannung		$-U_{EBO} = 10 \text{ V}$
Kollektorstrom		$-I_{CL} = 15 \text{ mA}$
Emitterstrom		$-I_{EL} = 15 \text{ mA}$
Basisstrom		$-I_{BL} = 5 \text{ mA}$
Gesamtverlustleistung		$P_{VL} = 30 \text{ mW}$
Sperrschichttemperatur		$\theta_{JL} = +75 \text{ }^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur		$\theta_{aL} = +65 \text{ }^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand		$R_{thja} \leq 1 \text{ grd/mW}$



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stambetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

23

GC 101		RFT electronic		
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 6\text{ V}$	$-I_{CBO}$		$1,5\ \mu\text{A}$	$15\ \mu\text{A}$
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 15\text{ V}$	$-I_{CBO}$		$50\ \mu\text{A}$	$500\ \mu\text{A}$
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CE} = 6\text{ V}$	$-I_{CEO}$		$55\ \mu\text{A}$	$600\ \mu\text{A}$
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CE} = 15\text{ V}$	$-I_{CEO}$		$50\ \mu\text{A}$	$500\ \mu\text{A}$
Dynamische Kennwerte				
Grenzfrequenz $-U_{CB} = 6\text{ V}$ $-I_C = 1\text{ mA}$ $f = 3\text{ MHz}$	f_{N21b}	1 MHz	2,1 MHz	Stromverstärkungs- gruppe
Kurzschlußstromverstärkung	h_{21E}	18 28 45 71 112	35 56 90 140 224	
Rauschmaß $-U_{CB} = 1\text{ V}$ $-I_C = 0,2\text{ mA}$ $f = 1\text{ kHz}$ $\Delta f = 1\text{ kHz}$ $R_s = 500\ \Omega$	F		5 dB 10 dB	
Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe B		Transistor GC 101 B		
KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) Stambetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)				